

面向 H. 264 视频编码和 SDR SDRAM 的存储控制后端设计

1. 系统概述

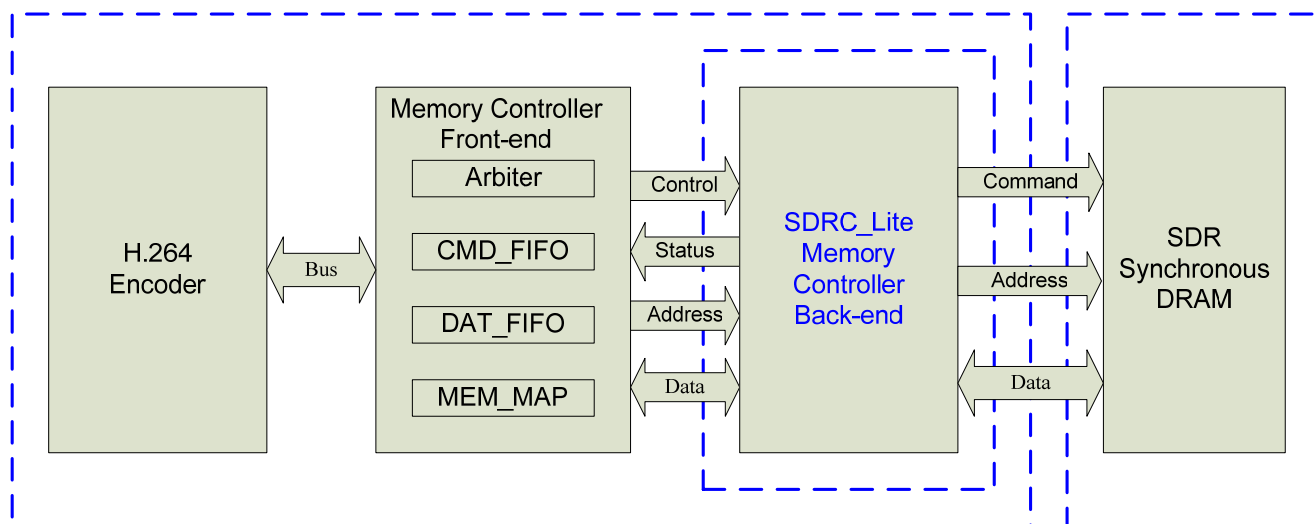
这份设计概要描述的是底层 SDR SDRAM 控制器，它相当于存储控制器的后端。在连接 H. 264 视频编码系统前，还需要连接存储控制器的前端。存储控制器的前端，主要包括：地址映射、请求仲裁、数据 FIFO 和指令 FIFO，是一个跨时钟域的单元。存储控制器的后端，主要控制 SDRAM 的刷新与读写操作，工作频率与 SDRAM 操作频率相同。

优秀的存储控制后端，可以减小读写延时，提高 SDRAM 系统中固有硬件带宽的有效利用率。

1.1 H. 264 视频编码与 SDR SDRAM 的存储控制后端

H. 264 编码应用与 SDRAM 存储系统的整体框图如下：

SDRC_Lite Memory Controller Back-end Beta2
System Block Diagram



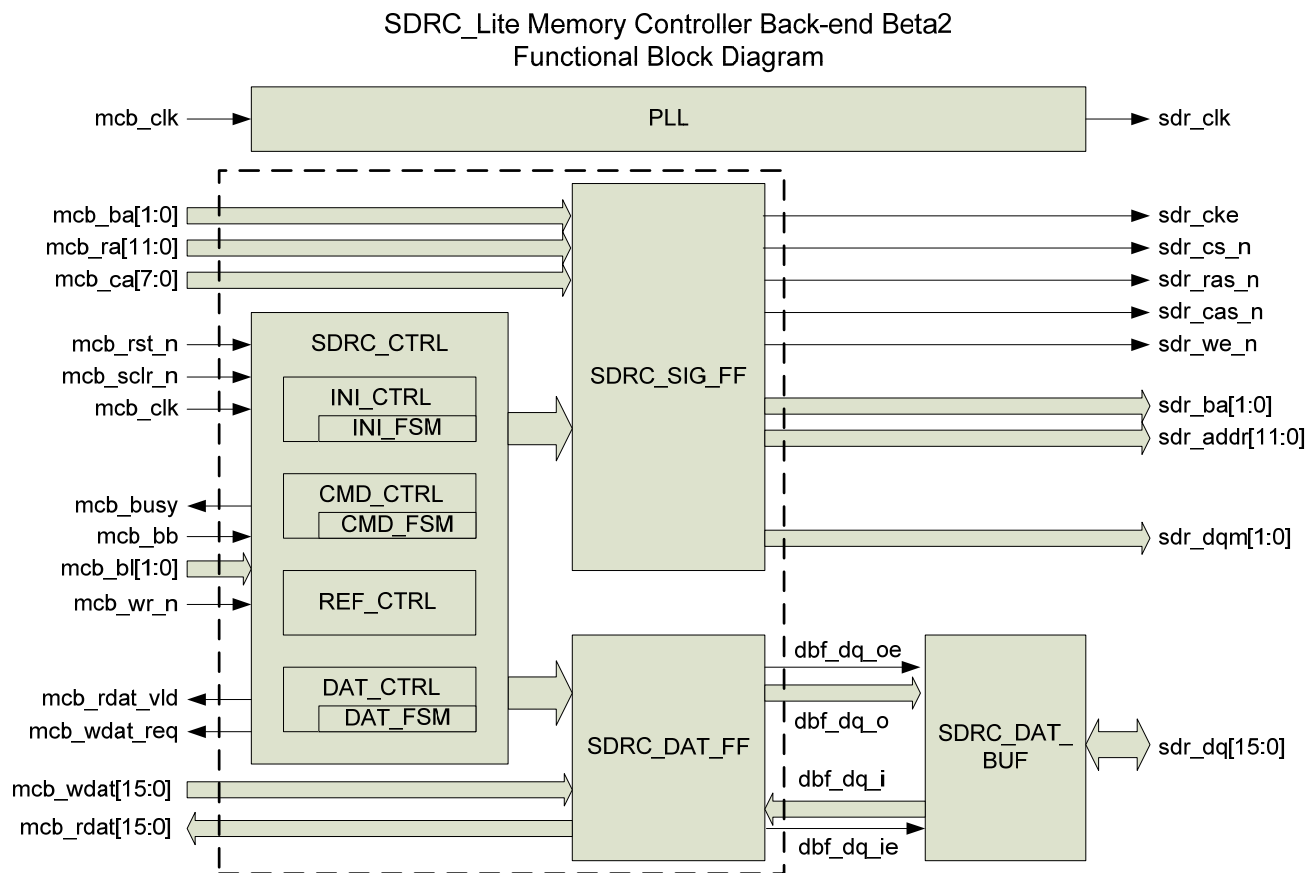
1.2 SDRC_Lite 存储控制后端的基本特点

简化的系统读写接口；全自动的 SDRAM 初始化、SDRAM 刷新控制；操作时序符合 PC100 标准和工业界实施标准。基于类 Close Page Policy 的操作原理，能稳定地保持低读写延时、高带宽利用率。

可动态调整的 Burst Length，每次发起读写时，都可以设置 Burst Length 为 4、8、12、16 中的任意值。

将数据位宽、地址位宽、SDRAM 器件的时序参数作为源代码中的 parameter，轻松适应不同的系统设置以及各厂商各型号的 SDR SDRAM 芯片。

1.3 存储控制后端顶层功能框图:



1.4 存储控制后端顶层信号说明:

(此处以容量为 64Mbit、位宽为 16 位的 SDR SDRAM 为例)

Signal Name	Direction	Description
(Interface to SDR SDRAM)		
sdr_clk	Output	SDRAM clock
sdr_cke	Output	SDRAM clock enable
sdr_cs_n	Output	SDRAM chip select
sdr_ras_n	Output	SDRAM row address strobe
sdr_cas_n	Output	SDRAM column address strobe
sdr_we_n	Output	SDRAM write enable
sdr_dqm[1:0]	Output	SDRAM input/output mask
sdr_ba[1:0]	Output	SDRAM bank address inputs

sdr_addr[11: 0]	Output	SDRAM address inputs
sdr_dq[15: 0]	I/O	SDRAM data input/output
(Interface to Memory Controller Front-end)		
mcb_clk	Input	MCB clock
mcb_rst_n	Input	MCB asynchronous reset
mcb_sclr_n	Input	MCB synchronous reset
mcb_bb	Input	MCB burst begin
mcb_rw_n	Input	MCB data direction: 0-write, 1-read
mcb_bl[1: 0]	Input	MCB burst length: 00-4, 01-8, 10-12, 11-16
mcb_ba[1: 0]	Input	MCB bank address
mcb_ra[11: 0]	Input	MCB row address
mcb_ca[7: 0]	Input	MCB column address
mcb_wdat[15: 0]	Input	MCB write data
mcb_rdat[15: 0]	Output	MCB read data
mcb_rdat_vld	Output	MCB read data valid
mcb_wdat_req	Output	MCB data to write request
mcb_busy	Output	MCB sdr sdram controller busy

1.5 备注

1.5.1 相对独立的模块

本设计中，由于硬件的原因，有两个模块相对独立。

PLL 模块。它负责时钟相位调整。控制器时钟经过 PLL 做相移后，输出给 DRAM 时钟信号 sdr_clk，以优化 SDRAM 操作的时序。相移参数的计算，可以参考 Altera 的文档。

SDRAM 读写三态缓冲模块。数据信号 DQ 是双向端口，其三态缓冲放在此模块中。

1.5.2 关于存储控制前端的规划

存储控制前端，将提供类似 Avalon Memory-Mapped Interfaces 的接口，内部包含地址映射、请求仲裁、数据 FIFO 和指令 FIFO 功能，实现跨时钟域的设计。

存储控制前端，一端与 H.264 编码系统连接，一端与本设计概要描述的控制器连接。

1.5.3 相对于上一版本(Alpha版)的变化:

- [1] 可改变的系统突发读写长度。可以通过 `mcb_bl`，将突发读写长度设为 4、8、12、16。
- [2] SDRAM 的 CL 确定为 3，BL 确定为 4，且模式寄存器初值不再是可调节参数。
- [3] 不再设外部 `refresh` 接口，`refresh` 完全由 SDRAM 控制器内部的计数器控制。
- [4] 指令状态机与数据状态机分离，进一步减小操作延时。

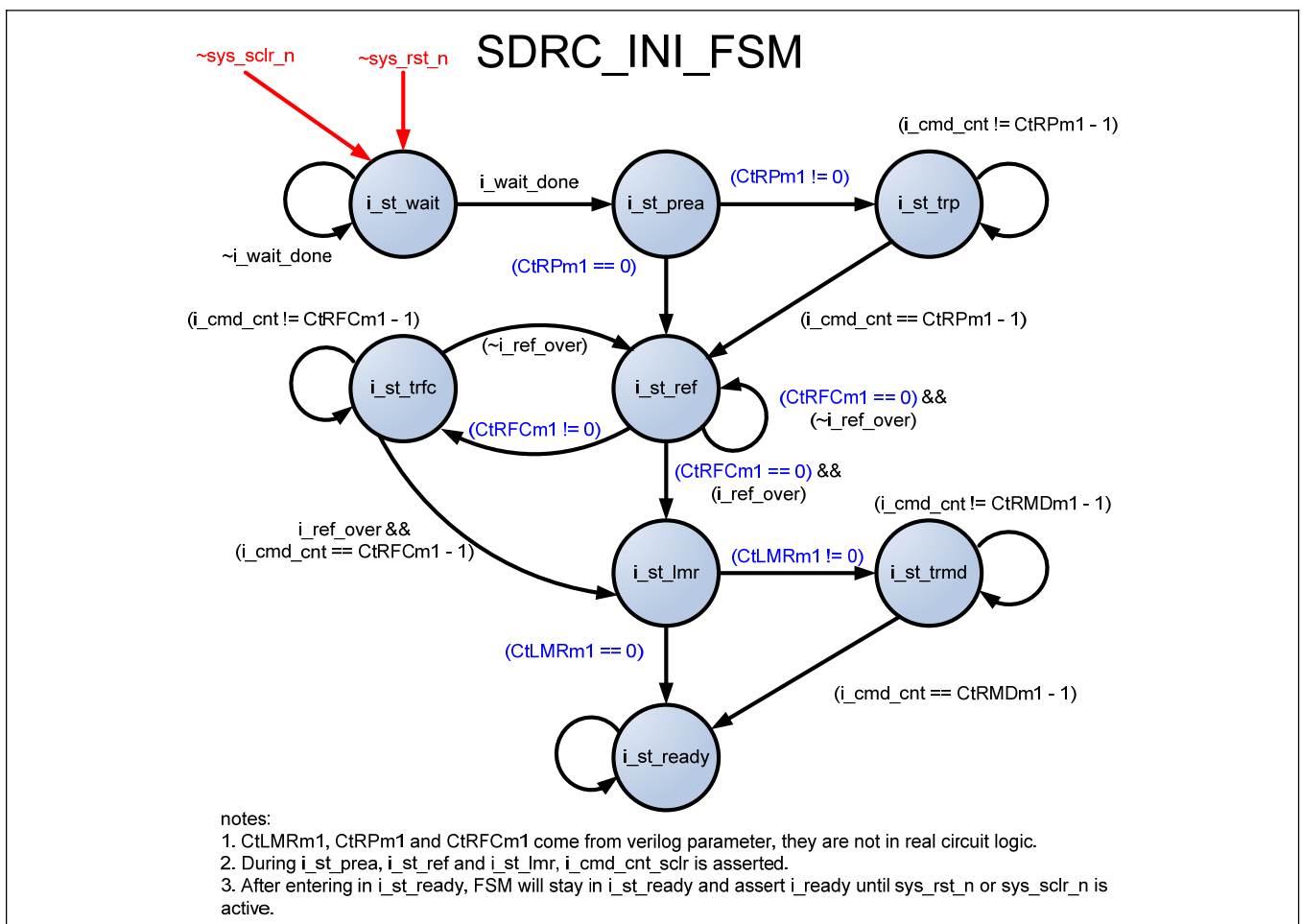
2. 存储控制后端核心控制逻辑的设计

2.1 初始化状态机

初始化状态机，控制 SDRAM 的上电初始化。设计时，参考了 Intel PC100 标准与工业界约定俗成的规范。初始等待时间、`refresh` 次数，将被作为源代码中的可配置参数。

SDR SDRAM 的初始化原理，详见我的《SDRC_lite_上电初始化__ver1.1_20120330》。

初始化状态机的状态转换图如下:



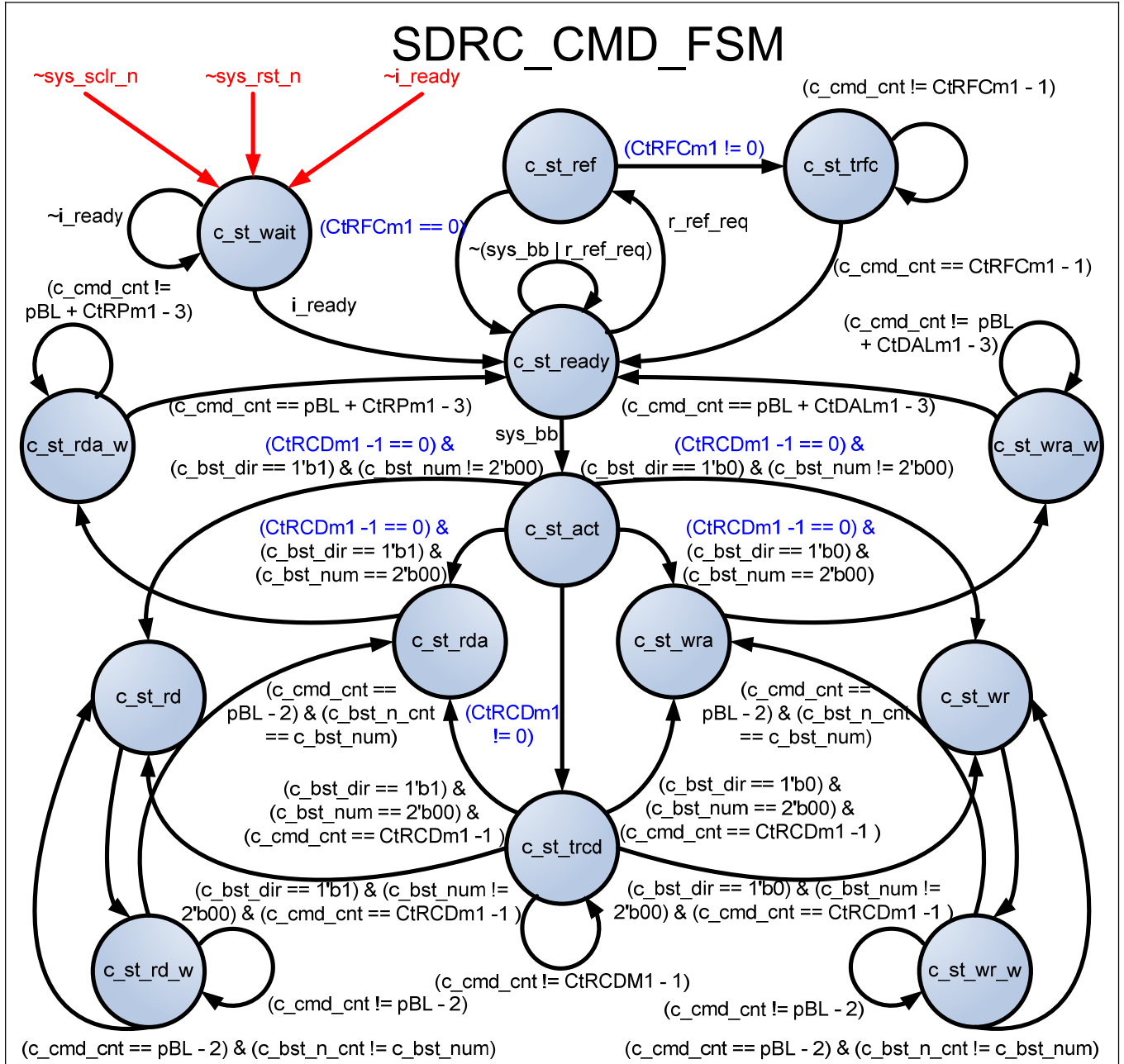
注：图中，蓝色的条件与系统时钟频率与 SDRAM 硬件参数有关，不会映射为硬件参数。

2.2 命令状态机

命令状态机，负责与存储控制前端交互、SDRAM 指令发送。它是本设计的核心部件，设计是依照的是优化过的类 Close Page Policy 思想。

Close Page Policy 的原理可参见我的《SDRC_lite_basic_knowledge__ver0.2_20120408》；关于可变突发长度的实现与 Close Page Policy 的优化，可参见我后续的关于操作时序的文档。

命令状态机的状态转化图如下：

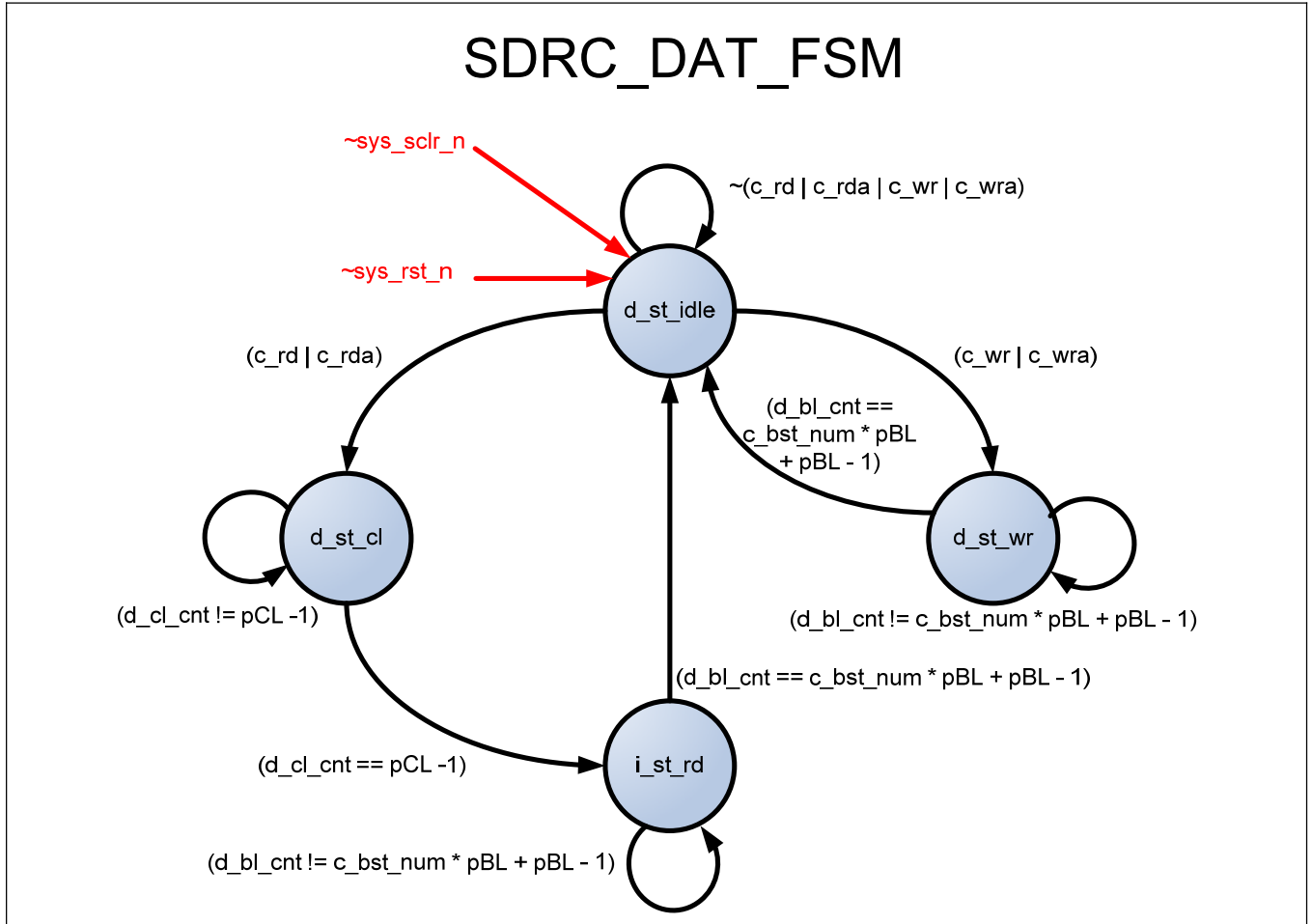


注：图中，蓝色的条件与系统时钟频率与 SDRAM 硬件参数有关，不会映射为硬件参数。

2.3 数据状态机

数据状态机，负责与 SDRAM、存储控制前端的数据交互。它减轻了主状态机(指令状态机)，使同时传送指令与数据成为可能，减小了读写延时。

数据状态机相对简单，其状态转换图如下：



3 读写操作的时序图

本次设计将严格按照，先出时序图，再出源代码，最后再仿真对比的原则，尽力杜绝“时序靠凑、时序靠仿”的不良设计习惯。

时序图使用 TimeGen 3.2 软件全手工绘制；绘制前，根据信号间的逻辑关系，参照 SDRAM 手册中的时序限制，打过草稿；电子版完成后，又反复检查，更正了一些不合理之处。

时序图包括 4 张：读取(Burst Length = 4)、读取(Burst Length = 8)、写入(Burst Length = 4)、写入(Burst Length = 8)。由于时序图涉及的周期长、信号多，此处画不下，单独放在一下文档中：《SDRC_lite_spec_beta2_timing_v0.1》。